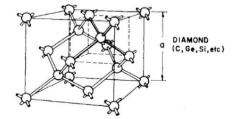
618327-2560

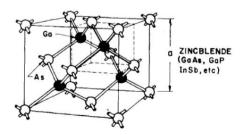
ฟิสิกส์ของวัสดุอิเล็กทรอนิกส์

และอุปกรณ์

นพ.อรทัย วัชรกิจจากร

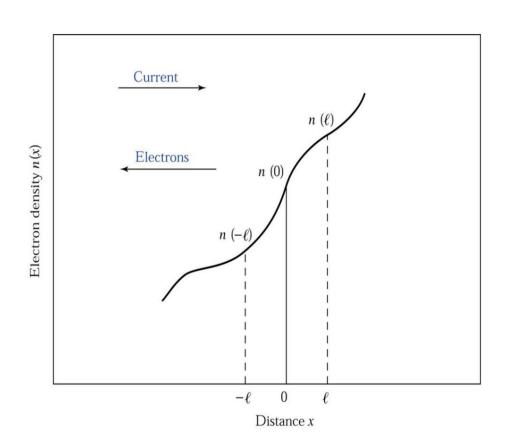
บทที่ 4





• กระแสดริฟท์คือการขนส่งของตัวพาเมื่อมีการใช้สนามไฟฟ้า

- มีกระแสพาหะสำคัญอีกกระแสหนึ่งเรียกว่า
 "กระแสการแพร่กระจาย". (อาร์การแพร))
- กระแสการแพร่กระจายนี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของความเข้มข้นของตัวพาในวัสดุ
- สารพาหะจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำ
- การเคลื่อนไหวประเภทนี้เรียกว่า "กระบวนการแพร่" (ฟิล์มแพร))



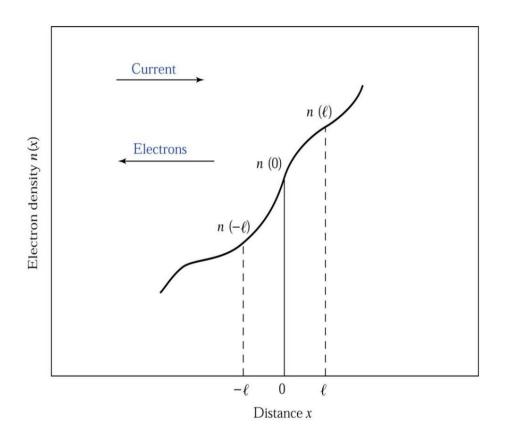
 ความหนาแน่นของอิเล็กตรอนจะแปรผันใน ทิศทาง x ภาย ใต้อุณหภูมิสม่ำเสมอ

กระจายเรื่องราวนี้

พลังงานความร้อนเฉลี่ยของอิเล็กตรอนจะไม่
 เปลี่ยนแปลงตาม x แต่ ความหนาแน่นของ
 อิเล็กตรอน n(x)
 เพราะเหตุใดเพราะความร=อนของอิเล็กตรอนจะ
 เปอานอิสระกับ x

 อิเล็กตรอนมี ความเร็วความร้อนเฉลี่ย vth และมี เส้นทางอิสระเฉลี่ย l

• การควบคุมการคำนวณส่วนที่เหลือ=องกำหนดอัตราการไหลของอากาศสุทธิของออตตจอหนึ่งหนุJueเวลาตตJอหนึ่งหนึ่พื้นที่ ก=ามที่ x=0 โดยที่ l จากรูปคือ หมายถึง เส้นทางอิสระ ของอิเล็กตรอน



 อิเล็กตรอนที่ x = -l มีโอกาสเคลื่อนที่ไปทาง
 ซ้ายหรือขวาเท่ากัน • ค่า เฉลี่ยของการไหล ของอิเล็กตรอน

ต่อหน่วยพื้นที่ F1 ของอิเล็กตรอน ระนาบตัดผ่าน x = 0 จาก ด้านซ้ายแสดงเป็น อัตราของโปรตีน F1 ใน ทิศทาง +x ที่ x = 0 (จากทางซ9ายมือ)คือ

ค่าเฉลี่ยของการไหลของอิเล็กตรอนต่อหน่วยพื้นที่ F2 ของ
 อิเล็กตรอนที่ x = l แผนตัดที่ x = 0 จากทางขวาคือ

เช@นเดียวกันอัตราของเฮลิคอปเตอร์โลหะ F2 ที่ x = l (จากทางขวามือ) คือ

- จากนั้นอัตราสุทธิของการไหลของอิเล็กตรอนจากซ้ายไปขวาคือ ให้โดย
- อัตราความเหมาะสมของฮาร์ดแวร์เขียนได9เปGน

ì é ùé dn í (θ) vn l
ú**ଢ଼ି θີ.**5 ê ເอ็ก**ตี**
$$u_{(0)} + \frac{20}{3}$$
 þ dx

$$loW = \int_{\text{ling}} \frac{dl_0}{dl_0}$$
 (1.3)

• ดังนั้นอัตราสุทธิ F สามารถเขียนได้เป็น

เอฟ**ี**ดี
$$u = \frac{\vec{n} \cdot \vec{b} \cdot \vec{u}}{\vec{n} \cdot \vec{b} \cdot \vec{u}}$$
 (2)

โดยที่ Dn = vth.l = ค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ (diffusivity)

(สัมประสิทธิ์การแพรJอิเล็กตรอน; cm2 /

วินาที) • ความหนาแน่นกระแสที่เกิดจากการแพร่ของอิเล็กตรอนคือ ให้โดย

คือ เกรเดียนต^ความเจ็บปวดแนจน์อิเล็กตรอน

ตัวอย่างที่ 1

สารกึ่งตัวนำชนิด n ที่ T = 300 K ความเข้มข้นของอิเล็กตรอนจะแปรผันเป็นเส้นตรง ตั้งแต่ 1 x 1018 ถึง 7 x 1017 cm-3 ในระยะทาง 0.1 ซม.
 คำนวณความหนาแน่นกระแสการแพร่กระจายถ้าค่าสัมประสิทธิ์การแพร่กระจายของ อิเล็กตรอน Dn เท่ากับ 22.5 cm2/s

ความสัมพันธ์ของไอน์สไตน์

• จากการอนุรักษ์พลังงานสำหรับกรณีมิติเดียว

เราสามารถเขียนได้

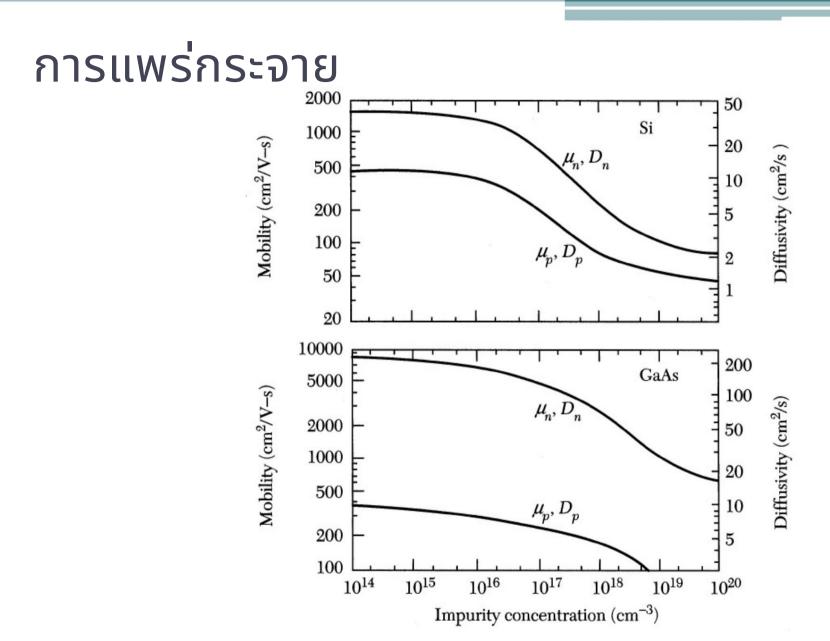
ความสัมพันธ์ของไอน์สไตน์

• ดังนั้น,

$$\vec{\Omega}_{u} = \varsigma + \hat{e}_{0} \not = \hat{e}_{0} \not = \hat{e}_{0} \not = \hat{e}_{0} \not= \hat{e}_{0} \not$$

• สิ่งนี้เรียกว่า "ความสัมพันธ์แบบไอน์สไตน์" (ความสัมพันธ^ของไอสไตน์^) เนื่องจากเกี่ยวข้องกับค่าคงที่ทั้ง สองที่อธิบายการขนส่งแบบแพร่และการดริฟท์ของตัวพา การ แพร่กระจาย และการเคลื่อนที่ ตามลำดับ (สัมประสิทธิ์การแพร@และคล@องตัว)

ความสัมพันธ์ของไอน์สไตน์นี้สามารถใช้กับหลุมได้เช่นกัน



Mobilities and diffusivities in Si and GaAs at 300 K as a function of impurity concentration.

ตัวอย่างที่ 2

พาหะกลุ่มน้อย (โฮล) จะถูกฉีดเข้าไปในตัวอย่างเซมิคอนดักเตอร์ชนิด n ที่เป็นเนื้อเดียวกันที่จุดหนึ่ง
 สนามไฟฟ้า 50 V/cm จะถูกนำไปใช้ทั่วตัวอย่าง และสนามไฟฟ้าจะเคลื่อนย้ายพาหะกลุ่มน้อยเหล่านี้เป็น
 ระยะทาง 1 ซม. ใน 100 µs หาความเร็วดริฟท์และการแพร่กระจายของพาหะกลุ่มน้อย T = 300 K

- สรุปได้ว่า เมื่อมีการนำสนามไฟฟ้ามาใช้
 นอกจากการไล่ระดับความเข้มข้นแล้ว กระแสดริฟท์ทั้งสอง และกระแสการแพร่กระจายจะไหล
- ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้ารวมที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนสามารถ
 เขียนเป็น

โดยที่ n = ความหนาแน่นของอิเล็กตรอน

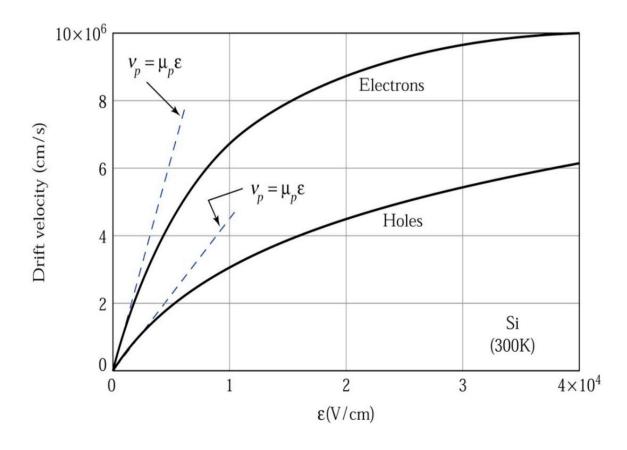
ความหนาแน่นกระแสการนำรวมจะกำหนดโดย

$$\log_{\text{\tiny hokuo}} \log_{\text{\tiny 5}} = + \tag{7}$$

โดยที่ Jh คือกระแสของรู

โดยที่ p คือความหนาแน่นของรู

• ที่สนามไฟฟ้ามีค่าสูงมาก ความเร็วดริฟท์จะอิ่มตัวในจุดที่เข้าใกล้ความเร็วความร้อน



อิเล็กตรอนเป็นคลื่น

แอล เดอ บรอยล์ กล่าวว่า อิเล็กตรอนที่มีโมเมนตัม p
 แสดงคุณสมบัติคล้ายคลื่นซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือความยาวคลื่น λ

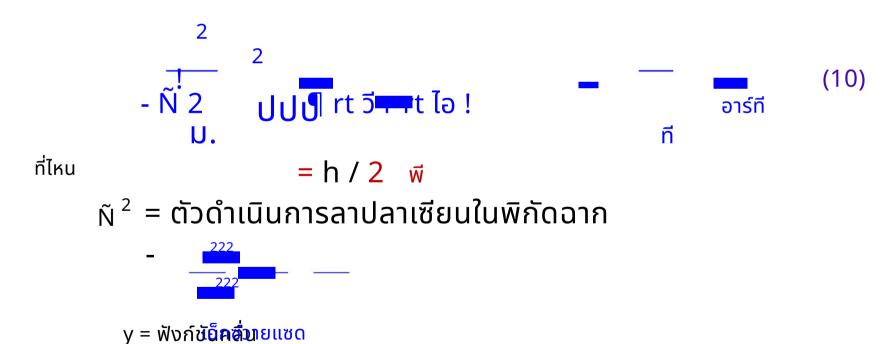
ที่ไหน h = ค่าคงที่ของพลังค์ = 6.62 x 10-34 Js

m = มวลอิเล็กตรอน

v = ความเร็วของอิเล็กตรอน

- พลังงานจลน์ + พลังงานศักย์ = พลังงานทั้งหมด
- สมการของชเรอดิงเงอร์อธิบายสมการคลื่นใน 3 มิติเขียนเป็น

V = เทอมศักย์



ในการแก้สมการ เราถือว่า

$$\mathbf{S}(s,n) = \mathbf{S}(s).(n)\mathbf{S}$$
 (11)

และแทนที่มันลงในสมการของชเรอดิงเงอร์ เราได้

$$-\frac{2}{2\mu} \partial_{0} \vec{N} \quad {}^{2}\mathbf{U}_{()()()() s > s} \mathbf{U} \mathbf{W} \qquad -\mathbf{U}_{\tilde{u}} - \mathbf{U}_{\tilde{u}} \vec{N} \qquad (12)$$

หารทั้งสองข้างด้วย <mark>ย (r).(๗</mark>) เรามี

$$-\frac{\overline{2} \tilde{N}^{2} \tilde{g} \tilde{s}}{2 u n u \tilde{g}} - \overline{3} \tilde{a} \tilde{s} \tilde{l} \tilde{b} - \frac{1}{\overline{0} \tilde{n}} \tilde{n} \frac{1}{\overline{0} \tilde{n}} \tilde{n} \tilde{n} \tilde{n}$$

$$(13)$$

- ทั้งสองจะเท่ากันได้ก็ต่อเมื่อแยกจากกันมีค่าคงที่ E เท่ากับ
 - 🛮 กรณีขึ้นอยู่กับระยะเวลา:

🛘 ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง: (ขึ้นอยู่กับเวลา)

พิจารณาส่วนที่ขึ้นอยู่กับเวลา เราสามารถแก้สมการได้ดังนี้

โดยที่
$$E = h$$
 $u = K_{2} / 2 \vec{w} = ฮะว$

ดังนั้น ;

เพื่อให้ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง เพื่อให้เข้าใจง่าย ให้ถือว่า
 อิเล็กตรอนสามารถเคลื่อนที่ได้ เพียงมิติเดียวเท่านั้น (ทิศทาง x)

$$-\frac{1}{2J} \cdot \frac{\vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \vec{v}}{2J \cdot \mathbf{O} \cdot \mathbf{C}} = \vec{b} \cdot \vec$$

ที่ไหน ยาการ เป็นที่จะพบอิเล็กตรอน

• ตอนนี้ลองพิจารณา 4 กรณีที่แตกต่างกันสำหรับ V(x)

วิธีแก้ทั่วไปของสมการนี้คือ

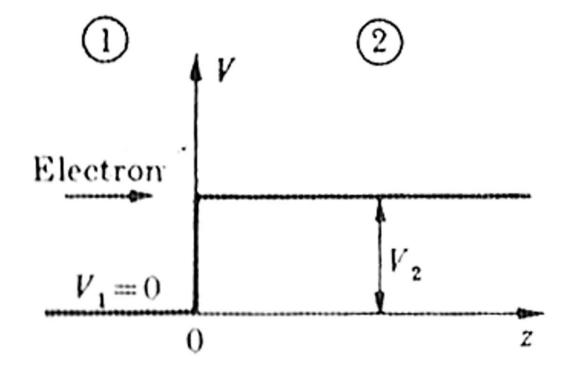
โดยที่ A และ B คือแอมพลิจูดของการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและถอยหลัง คลื่นแพร่กระจายและ k เกี่ยวข้องกับ E โดย

$$\vec{5} - \frac{-2i\hbar}{2\nu} - \frac{12}{2}i\delta\nu\vec{5}$$
 (22)

$$\vec{W}$$
IP = ! (23)

สมการนี้เรียกว่า "ความสัมพันธ์ของเดอบรอยล์"

• <u>กรณี ที่ 2 :</u> อุปสรรคศักย์ขั้นบันได (1 มิติ)



สำหรับ ภูมิภาค 1 โซลูชันนี้เป็นที่รู้จักแล้ว

$$k_1^2 = \frac{2mE}{2}$$
 (24.2)

สำหรับ ภูมิภาค 2 สมการ (18) จะกลายเป็น

• วิธีแก้ปัญหาทั่วไป:

• เนื่องจากไม่มีคลื่นตกกระทบจาก <mark>ภูมิภาค</mark> 2 **D** จึงต้องเป็นศูนย์

• โดยการใช้เงื่อนไขขอบเขต การแก้ปัญหา จะต้องต่อเนื่อง ที่ x = 0 ด้วย

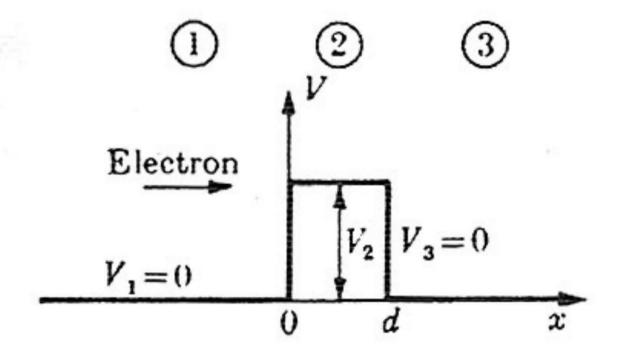
• จาก (24) และ (25) เราได้

ตอนนี้ลองพิจารณา 2 กรณี:

1. E > V2: ในกรณีนี้ k2 เป็น จริง k2 และ k1 ต่างกันที่นำ B/A เชิงจำกัด ซึ่ง หมายความว่าอิเล็กตรอนสามารถมองเห็นได้ทั้งใน บริเวณ 1 และ 2 อิเล็กตรอนเคลื่อน ผ่านสิ่งกีดขวางและสารละลายจะแกว่ง ไป มาในอวกาศในบริเวณทั้งสอง

2. E <u> V2 ในก</u>รณีนี้ k2 เป็น ค่าจินตภาพ คำตอบแสดงให้เห็นว่าอิเล็กตรอนสลายตัว แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลใน บริเวณ 2 อิเล็กตรอนอาจทะลุผ่านสิ่งกีดขวางศักย์ไฟฟ้าได้

• <u>กรณี ที่ 3:</u> กำแพงศักย์ไฟฟ้าความกว้างจำกัด (1 มิติ)



เราสนใจกรณีของ E < V2 ในกรณีนี้ โซลูชันสำหรับ ภูมิภาค 1 และ ภูมิภาค 2
 จะเหมือนกัน
 กรณีที่แล้ว ตอนนี้เราหันมาสนใจ ภูมิภาค ที่ 3 กัน บ้าง
 ที่ เขต 3

$$\mathbf{U}_{3}(\mathbf{x}) \mathbf{I} \mathbf{W} = \mathbf{0}^{3} \mathbf{U}_{3}^{X}$$
 (27.1)

$$k_3^2 = \frac{2mE}{2}$$
 (27.2)

 พิจารณาการส่งผ่าน T คืออัตราส่วนของพลังงานใน คลื่นที่ส่งผ่านใน บริเวณ 3 เป็นพลังงานในคลื่นตกกระทบ ใน เขตพื้นที่ 1.

> ที - พลังงานในคลื่นที่ส่งผ่านในบริเวณ 3 พลังงานในคลื่นตกกระทบบริเวณที่ 1

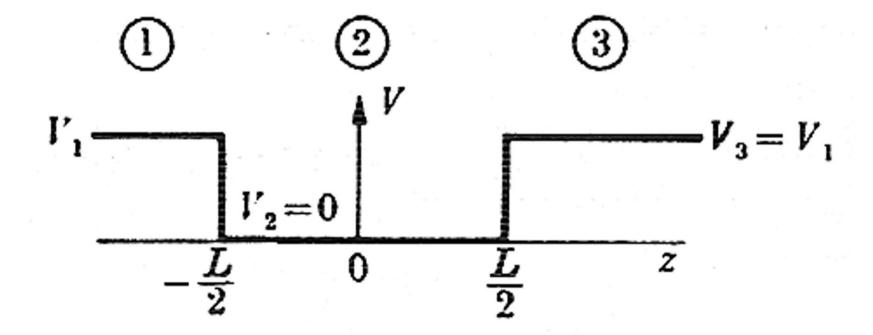
ที -
$$\frac{\left| \text{เอฟ} \right|^2}{\left| \text{เอ} \right|^2}$$
 ฉันเอ๊าซ์พอกฉัน d $\sqrt{\frac{2 เอ็นวี อีอุ) \ddot{\text{I}} - \acute{\text{y}}}{-2}}$ (28)

• สิ่งนี้เรียกว่า "ความน่าจะเป็นในการสร้างอุโมงค์"

• k3 เป็นจริง ดังนั้น

- \mathbf{g}_{3} ໄນ່ ເປັນ ศูนย์.
- ดังนั้น จึงมีความน่าจะเป็นที่อิเล็กตรอนจะข้ามสิ่งกีดขวางและไปปรากฏที่อีกด้าน หนึ่ง
- เนื่องจากอนุภาคไม่เคลื่อนที่ข้ามสิ่งกีดขวางเนื่องจาก E < V2 กลไกที่อนุภาค
 สามารถเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางได้จึงเรียกว่า "การขุดอุโมงค์"

• กรณี ที่ 4 : บ่อน้ำศักยภาพจำกัด (1 มิติ)



พิจารณา 2 กรณี

1. E > V1: วิธีแก้ปัญหาในทุกภูมิภาคคล้ายคลึงกับกรณีที่ผ่านมา นั่นคือ อนุภาค เคลื่อนที่แบบแกว่งไปแกว่งมาในทุกที่

2. E <u>< V1: ภูมิภาค</u> 1 (x < -L/2, V = V1) คำตอบจะต้องสลายตัวแบบเลขชี้กำลัง

$$\mathbf{U} \ \mathbf{1}(\mathbf{x}) \ \mathbf{Io} \mathbf{\bar{o}} = \mathbf{\bar{u}} \mathbf{u}_{\mathbf{1}}^{\mathbf{x}}$$
 (29.1)

$$\frac{2}{\ln 1} - \frac{2(1) \ln \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}}{2}$$
 (29.2)

• ภูมิภาค 2 (V = 0) กรณีอนุภาคอิสระ

• ภูมิภาค 3 (x >L/2 , V3 = V1) สารละลายกำลังสลายตัวอีกครั้ง

$$\mathbf{8}_{3}$$
 (\mathbf{x} to = $\mathbf{31.1}$)

$$\frac{2}{10} - \frac{2(1) \text{ u.5.5}}{2} - \frac{2}{10}$$
 (31.2)

การใช้เงื่อนไขขอบเขต:

ดีเอ็กซ์

 $\vec{n} x = L/2$

ดีเอ็กซ์

สามารถแก้ได้เฉพาะที่ x = L/2 เท่านั้น เนื่องจากมีสมมาตร

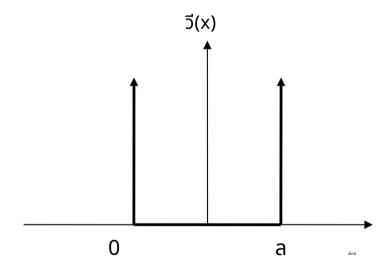
$$rac{\partial \mathbf{C}_{\mathbf{A}_{3}}\ddot{\mathbf{O}}_{\mathbf{A}_{3}}}{\nabla \mathbf{C}_{\mathbf{A}_{3}}\ddot{\mathbf{C}}_{\mathbf{A}_{3}}} - \vec{\mathbf{C}}_{\mathbf{A}_{3}}\ddot{\mathbf{O}}_{\mathbf{A}_{3}}$$
 (32)

โดยการแก้สมการ (32) จะนำไปสู่

• แทนค่า (33) ลงใน (30.2) และ (31.2) เราจะได้

$$\sqrt{5}$$
 ιιηυ $\sqrt{\frac{5}{2-2}}$ $\div = \sqrt{5}$ \div

ถ้าเราพิจารณาในกรณีของ V à ¥ หรือ ศักยภาพอนันต์ก็ดี



เป็นไปไม่ได้ที่อนุภาคจะสามารถทะลุผ่านได้
 อุปสรรคที่ไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งจะทำให้ y(x) = 0 ที่ x = 0 และ x = L
 โดยใช้เงื่อนไขขอบเขต ก่อนอื่นเราจะมี B = 0 และ

• เราสามารถแก้หาพลังงาน E ได้

$$\vec{\mathbf{5}}_{\mathsf{u}} = \frac{\frac{22}{15\mathsf{u} \log 3}}{8 \, \mathsf{ua}^2} \tag{36}$$